

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2005 年 9 月 15 日 (15.09.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/086210 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 21/205, 21/3065, C23C 16/44
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/004205
- (22) 国際出願日: 2005 年 3 月 10 日 (10.03.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2004-067174 2004 年 3 月 10 日 (10.03.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社アルバック (ULVAC, INC.) [JP/JP]; 〒2538543 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2 5 0 0 番地 Kanagawa (JP).

料研究所内 Chiba (JP). 大園 修司 (OOSONO, Shuuji) [JP/JP]; 〒2891226 千葉県山武郡山武町横田 5 2 3 番地 株式会社アルバック 千葉超材料研究所内 Chiba (JP). 伊藤 博巳 (ITOU, Hiromi) [JP/JP]; 〒2891226 千葉県山武郡山武町横田 5 2 3 番地 株式会社アルバック 千葉超材料研究所内 Chiba (JP). 斎藤 一也 (SAITOU, Kazuya) [JP/JP]; 〒2891226 千葉県山武郡山武町横田 5 2 3 番地 株式会社アルバック 千葉超材料研究所内 Chiba (JP). 浅利 伸 (ASARI, Shin) [JP/JP]; 〒2891226 千葉県山武郡山武町横田 5 2 3 番地 株式会社アルバック 千葉超材料研究所内 Chiba (JP).

- (74) 代理人: 北村 欣一, 外 (KITAMURA, Kinichi et al.); 〒1050004 東京都港区新橋 2 丁目 1 6 番 1 号 ニュー新橋ビル 7 0 3 Tokyo (JP).

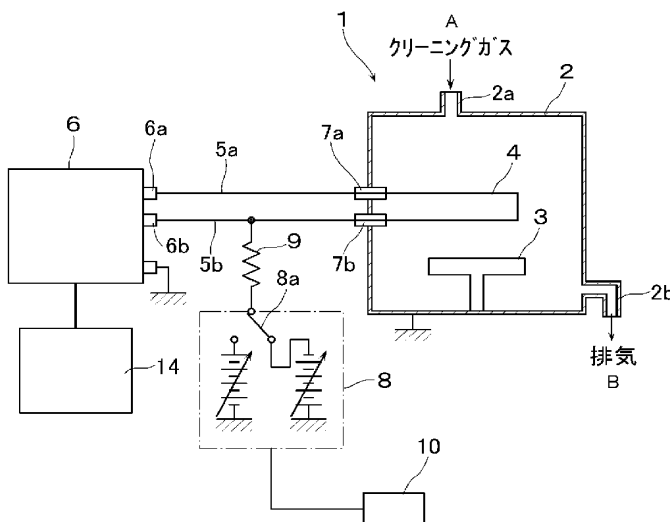
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 北添 牧子 (KITAZOE, Makiko) [JP/JP]; 〒2891226 千葉県山武郡山武町横田 5 2 3 番地 株式会社アルバック 千葉超材

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

[続葉有]

(54) Title: SELF-CLEANING CATALYST CHEMICAL VAPOR DEPOSITION DEVICE AND CLEANING METHOD THEREFOR

(54) 発明の名称: セルフクリーニング触媒化学蒸着装置及びそのクリーニング方法



A CLEANING GAS  
B EXHAUST

(57) Abstract: A self-cleaning catalyst chemical vapor deposition device capable of preventing the corrosion and deterioration of a catalyst element by a cleaning gas without heating the catalyst element to at least 2000°C, and realizing practical, low-cost cleaning speed and satisfactory cleaning. When a cleaning gas containing a halogen element is introduced into a evacuated reaction vessel (2) to heat the catalyst element (4) by current supply from the heating power supply (6), and active species produced by this heating is allowed to react with a deposited film on the inside of the reaction vessel (2) to remove the deposited film, with heating power supply (6) and conductors (5a, 5b) feeding a constant current from between respective terminals (6a, 6b) of the power supply (6) to a catalyst element (4) in a reaction vessel (2) kept electrically insulated from the reaction vessel (2), a proper value of dc bias voltage is applied to the conductor (5b) of the heating power supply (6) with a proper polarity from a constant-voltage power supply (8).

(57) 要約: 触媒体を 2000°C 以上に加熱することなく、クリーニングガスによる触媒体の腐食劣化を抑制して、実用的なクリーニング速度及び良

好なクリーニングを低コストで行うことができるセルフクリーニング触媒化学蒸着装置を提供する。加熱用電源 6 及び該加熱用電源 6 の各端子 6a、6b 間から反応容器 2 内の触媒体 4 に定電流を通電する導線 5a、5b を反応容器 2 と電気的に絶縁した状態として、排気された反応容器 2 内にハロゲン元素を含有するクリーニングガスを導入して加熱用電源 6 からの通電によって触媒体 4 を加熱し、この加熱によって生成された活性種を反応容器 2 内に付着している付着膜と反応させて付着膜を除去する際に、加熱用電源 6 の導線 5b に、定電圧電源 8 から適切な極性で適切な値の直流バイアス電圧を印加する。

WO 2005/086210 A1



ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),  
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,  
MR, NE, SN, TD, TG).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

## 明 細 書

### セルフクリーニング触媒化学蒸着装置及びそのクリーニング方法 技術分野

- [0001] 本発明は、触媒化学蒸着装置内でクリーニングガスによる触媒体の腐食劣化を抑制し、実用的なクリーニング速度及び良好なクリーニングを可能にするセルフクリーニング触媒化学蒸着装置及びそのクリーニング方法に関する。

### 背景技術

- [0002] 各種半導体デバイスやLCD(液晶ディスプレイ)等を製造する際において、基板上に薄膜を成膜する方法として例えばCVD法(化学蒸着法)が従来より用いられている。

CVD法としては、熱CVD法、プラズマCVD法などが従来より知られているが、近年、加熱したタングステン等の素線(以下、「触媒体」という)を触媒として、この触媒体による触媒作用により反応室内に供給される原料ガスを分解することによって基板に薄膜を堆積させる触媒CVD法(Cat-CVD法又はホットワイヤCVD法とも呼ばれている)が実用化されている。

- [0003] 触媒CVD法は、熱CVD法に比べて低温で成膜を行うことができ、また、プラズマCVD法のようにプラズマの発生によって基板にダメージが生じる等の問題もないので、次世代の半導体デバイスやLCDなどの表示デバイスの成膜方法として注目されている。

このような触媒CVD法によって成膜を行う触媒CVD装置では、熱CVD装置やプラズマCVD装置と同様に、成膜過程で分解された原料ガスが基板に堆積膜を形成する際に、分解された原料ガスの一部は反応容器の内壁や基板載置台等にも膜として付着する。

これらの付着した膜が堆積するとやがて剥離して反応容器内を浮遊し、基板に付着することによって処理品質の低下を招くことになる。

- [0004] このため、適宜、反応容器の内壁や基板載置台等に付着した膜(以下、「付着膜」という)を除去する必要がある。この付着膜を除去するin situ(その場)クリーニング方

法として、従来、HF、NF<sub>3</sub>、SF<sub>6</sub>、CF<sub>4</sub>などのハロゲン元素を含有するクリーニングガスを反応容器内に導入し、加熱した発熱体である触媒体によるクリーニングガスの分解によって発生するハロゲン含有ラジカル種を付着膜と反応させて除去する方法が一般に採用されている。

[0005] このような従来のクリーニング方法では、原料ガスの分解に用いる加熱したタングステン等の触媒体を上記クリーニングガスの分解にも用いるため、このときに発生するハロゲン含有ラジカル種の一部と触媒体とが反応して触媒体がエッチングされ腐食劣化を引き起こすことにより、クリーニング後に成膜しようとする所定の発熱特性が得られず、膜の堆積速度の再現性が損なわれてしまう等の問題があった。

[0006] このため、上記のような問題を解決するために、タングステン等の触媒体を2000℃以上に加熱して触媒体とクリーニングガスとの反応にともなう触媒体のエッチング(腐食劣化)を抑制するようにしたクリーニング方法が提案されている(例えば、特許文献1参照。 )。

特許文献1:特開2001-49436号公報

## 発明の開示

### 発明が解決しようとする課題

[0007] しかしながら、上記特許文献1記載のクリーニング方法では、タングステン等の触媒体(発熱体)を2000℃以上に加熱する必要があるため、2000℃以上に加熱された触媒体自体の蒸発による劣化や、この蒸発にともなう触媒体の構成元素によって反応容器(処理室)内が汚染されるおそれがあり、改善の余地がある。

[0008] また、触媒体を2000℃以上に加熱することにより、触媒体付近に設けられる構成部材や反応容器の内壁も触媒体からの輻射熱によって高温になるので、耐熱性を有し、かつ熱による放出ガスの少ない部材を用いる必要があり、使用できる部材が限定されコストが高くなる等、改善の余地がある。

[0009] 本発明は、このような課題にかんがみ、触媒体を2000℃以上に加熱することなく、クリーニングガスによる触媒体の腐食劣化を抑制して、実用的なクリーニング速度及び良好なクリーニングを低コストで行うことができるセルフクリーニング触媒化学蒸着装置及びそのクリーニング方法を提供することを目的とする。

## 課題を解決するための手段

[0010] 上記目的を達成するために、本発明のセルフクリーニング触媒化学蒸着装置のうち請求項1記載の発明は、真空排気可能な反応容器内で抵抗加熱した触媒体の触媒作用を利用して薄膜を形成する触媒化学蒸着装置において、触媒体にバイアス電圧を印加するための電源と、印加するバイアス電圧の極性を切り換える切換えスイッチとを備え、導入したクリーニングガスが抵抗加熱した触媒体に接触し分解して発生したラジカル種と、触媒体に印加したバイアス電圧と極性とに基づいて、触媒体自体のエッチングをすることなく、反応容器内に付着した付着膜を除去する構成を有している。

また請求項2記載の発明は、上記構成に加え、クリーニングガスをラジカル種に分解して反応容器に導入するラジカル種発生器を設けたことを特徴とするものである。

さらに請求項3記載の発明は、クリーニングガスが、ハロゲン元素含有ガスと、不活性ガス及び還元性ガスのいずれかとの混合ガスであることを特徴とするものである。

請求項4記載の発明は、クリーニングガスが不活性ガス及び還元性ガスのいずれかを含んでおり、不活性ガス及び還元性ガスの種類に基づいたバイアス電圧の極性にすることを特徴とするものである。

[0011] 請求項5記載の発明は、所定極性のバイアス電圧が零のとき、クリーニングガスがハロゲン元素含有ガスと還元性ガスとの混合ガスである構成とした。

請求項6記載の発明は、ハロゲン元素含有ガスが、 $\text{NF}_3$ 、 $\text{HF}$ 、 $\text{C}_2\text{F}_6$ 、 $\text{C}_3\text{F}_8$ 、 $\text{SF}_6$ 、 $\text{CF}_4$ 、 $\text{CClF}_3$ 、 $\text{C}_2\text{ClF}_5$  及び  $\text{CCl}_4$  のいずれか、或いはこれらの組み合わせであり、還元性ガスが $\text{H}_2$  であり、不活性ガスが希ガスである構成を有している。

請求項7記載の発明は、クリーニングガスがハロゲン元素含有ガスと $\text{H}_2$  との混合ガスであって、正極性のバイアス電圧を印加する構成を有している。

請求項8記載の発明は、クリーニングガスがハロゲン元素含有ガスと $\text{Ar}$  との混合ガスであって、負極性のバイアス電圧を印加する構成を有している。

請求項9記載の発明は、触媒体自体のエッチングの発生を触媒体の電気抵抗に基づいて検出する監視装置を設けたものである。

[0012] 本発明の触媒化学蒸着装置のクリーニング方法のうち請求項10記載の発明は、真

空排気可能な反応容器内で抵抗加熱した触媒体の触媒作用を利用して薄膜を形成する触媒化学蒸着装置のクリーニング方法であって、抵抗加熱した触媒体に所定極性のバイアス電圧を印加する過程と、クリーニングガスを導入する過程と、抵抗加熱した触媒体にクリーニングガスが接触し分解してラジカル種を発生する過程と、反応容器内に付着した付着膜を除去するが触媒体自体をエッチングしない過程とを備えた構成を有している。

また請求項11記載の発明は、クリーニングガスを導入する過程が、クリーニングガスをラジカル種に分解して反応容器内に導入する過程であることを特徴とするものである。

さらに請求項12記載の発明は、クリーニングガスが、ハロゲン元素含有ガスと、不活性ガス及び還元性ガスのいずれかとの混合ガスであることを特徴とするものである。

請求項13記載の発明は、クリーニングガスが不活性ガス及び還元性ガスのいずれかを含んでおり、不活性ガス及び還元性ガスの種類に基づいて決定した極性のバイアス電圧を印加することを特徴とするものである。

[0013] 請求項14記載の発明は、所定極性のバイアス電圧が零のとき、クリーニングガスがハロゲン元素含有ガスと還元性ガスとの混合ガスであることを特徴とするものである。

請求項15記載の発明は、ハロゲン元素含有ガスが、 $\text{NF}_3$ 、 $\text{HF}$ 、 $\text{C}_2\text{F}_6$ 、 $\text{C}_3\text{F}_8$ 、 $\text{SF}_6$ 、 $\text{CF}_4$ 、 $\text{CClF}_3$ 、 $\text{C}_2\text{ClF}_5$  及び  $\text{CCl}_4$  のいずれか、或いはこれらの組み合わせであり、還元性ガスが $\text{H}_2$ であり、不活性ガスが希ガスであることを特徴とするものである。

請求項16記載の発明は、クリーニングガスがハロゲン含有ガスと $\text{H}_2$ との混合ガスであって、正極性のバイアス電圧を印加することを特徴とする。

請求項17記載の発明は、クリーニングガスがハロゲン含有ガスとArとの混合ガスであって、負極性のバイアス電圧を印加することを特徴とする。

請求項18記載の発明は、クリーニング中、その場で触媒体自体のエッチングの発生を電気抵抗に基づいて監視することを特徴とするものである。

## 発明の効果

[0014] 本発明によるセルフクリーニング触媒化学蒸着装置及びそのクリーニング方法によ

れば、触媒体を2000℃以上に加熱しなくてもクリーニングガスによる触媒体の腐食劣化を抑制することができ、実用的なクリーニング速度を得て反応容器の内壁等に付着した付着膜を除去することができるという効果を有する。

また、クリーニングガスによる触媒体の腐食劣化が抑制されることによって、成膜時においても安定して良好な膜を基板上に堆積(成膜)することができる。

さらに、クリーニング時に触媒体を2000℃以上に加熱する必要がないので、触媒体自体の蒸発による劣化や、この蒸発にともなう触媒体の構成要素によって反応容器内が汚染されることもなく、また、融点の低い廉価な部材を使用することができるのでコストの低減を図れるようになる。

### 図面の簡単な説明

[0015] [図1]本発明の実施形態1に係るクリーニング方法によってクリーニングを行うセルフクリーニング触媒化学蒸着装置を示す概略構成図。

[図2]クリーニングガスとして“ $\text{NF}_3$ と $\text{H}_2$ の混合ガス”の混合ガスを使用したときの、バイアス電圧を印加した場合と印加しない場合における加熱用電源の端子間発生電圧の変化を示す図。

[図3]クリーニングガスとして“ $\text{NF}_3$ とArの混合ガス”の混合ガスを使用したときの、バイアス電圧を印加した場合と印加しない場合における加熱用電源の端子間発生電圧の変化を示す図。

[図4]クリーニングガスとして“ $\text{NF}_3$ と $\text{H}_2$ の混合ガス”又は“ $\text{NF}_3$ とArの混合ガス”を使用したときの、加熱用電源の端子間発生電圧の変化を示す図。

[図5]本発明の実施形態3に係るクリーニング方法によってクリーニングを行うセルフクリーニング触媒化学蒸着装置を示す概略構成図。

### 符号の説明

- [0016]    1、20        セルフクリーニング触媒化学蒸着装置
- 2        反応容器
- 4        触媒体
- 6        加熱用電源
- 8        定電圧電源

10 制御装置

11 クリーニングガス分解用容器

14 監視装置

### 発明を実施するための最良の形態

[0017] 本発明のセルフクリーニング触媒化学蒸着装置は、真空排気可能な反応容器内で抵抗加熱した触媒体の触媒作用を利用して薄膜を形成する触媒化学蒸着装置において、触媒体にバイアス電圧を印加するための電源と、印加するバイアス電圧の極性を切り換える切換えスイッチとを備え、導入したクリーニングガスが抵抗加熱した触媒体に接触し分解して発生したラジカル種と、触媒体に印加したバイアス電圧と極性とに基づいて、触媒体自体のエッチングをすることなく、反応容器内に付着した付着膜をエッチングして除去するものである。

以下、図1～図5に基づき、実質的に同一又は対応する部材には同一符号を用いて、本発明による最良の実施形態について説明する。

#### [0018] 〈実施形態1〉

先ず実施形態1について説明する。

図1は、本発明の実施形態1に係るセルフクリーニング触媒化学蒸着装置を示す概略構成図である。

このセルフクリーニング触媒化学蒸着装置1は、反応容器2と、この反応容器2内に設けられた、基板(不図示)が載置される基板載置台3と、反応容器2内に供給される原料ガスを加熱して分解するための触媒作用を有する直径0.5mmのタングステン線からなる触媒体4を備えている。

[0019] 触媒体4は、クリーニング時には反応容器2内に供給されるクリーニングガスを加熱分解し、触媒体4に接触することによりラジカル種を発生させる。

このような触媒作用を有する触媒体として、タングステン線の他に、インジウム、モリブデン、タンタル及びニオブ等が使用可能であり、さらにこれらの合金でもよい。

反応容器2は、反応容器2のクリーニング時にクリーニングガスを供給し、成膜時に原料ガスを供給するためのガス供給系(不図示)と、反応容器2を真空排気してその内部の圧力を調整するためのガス排気系(不図示)とを備えており、図1に示すように



ガス供給口2aからクリーニングガスを導入し、ガス排気口2bから真空排気されるようになっている。

[0020] クリーニングガスとしては、 $\text{NF}_3$ 、 $\text{HF}$ 、 $\text{C}_2\text{F}_6$ 、 $\text{C}_3\text{F}_8$ 、 $\text{SF}_6$ 、 $\text{CF}_4$ 、 $\text{CClF}_3$ 、 $\text{C}_2\text{ClF}_5$  及び  $\text{CCl}_4$  等のハロゲン元素含有ガスと、 $\text{H}_2$  などの還元性ガス及びArなどの不活性ガスのいずれかとの混合ガスが用いられる。

不活性ガスとしてはArと同類の希ガスが使用可能である。

触媒体4には、導線5a、5bを介して定直流電源の加熱用電源6が接続されており、加熱用電源6から定電流制御された直流電圧が印加されることによって、触媒体4が抵抗加熱されるようになっている。

一端側が加熱用電源6の各端子6a、6bに接続されている各導線5a、5bは、絶縁部材7a、7bによって反応容器2と電氣的に絶縁されており、また、反応容器2と加熱用電源6は接地されている。

[0021] このように、加熱用電源6と各導線5a、5bは、反応容器2に対して電氣的に絶縁され、加熱用電源6と各導線5a、5bとによって、触媒体4への給電回路が構成されている。この加熱用電源6は、定電流制御された交流電源でもよい。

また、加熱用電源6と触媒体4とを電氣的に接続する一方の導線5bには、加熱用電源6から触媒体4に印加される電位を制御するための定直流電源である定電圧電源8が抵抗器9を介して接続されている。

定電圧電源8は、印加するバイアス電圧の極性を切り換えるための切換えスイッチ8aを有しており、接続されている制御装置10からの制御信号によって、印加するバイアス電圧の極性を切り換えることができるようになっている。

[0022] さらに定電圧電源8は、制御装置10からの制御信号によって、所望の極性、正極性又は負極性の電位値に制御されたバイアス電圧を抵抗器9を介して触媒体4に印加し、加熱用電源6から触媒体4に印加する電位、つまり、加熱用電源6の端子間電圧を制御することができるようになっている(詳細は後述する)。

印加するバイアス電圧の極性は、抵抗加熱する触媒体4自体のエッチングが生じないようにするために設定するものであり、導入する不活性ガス及び還元性ガスの種類に応じて適宜切り換え可能である。

[0023] 実施形態1では、定電流源6の出力端子6a、6b間の電圧を検出して、触媒体4自体のエッチングの発生を検出する監視装置14が設けられている。

触媒体4の抵抗加熱の給電に定電流源を使用する場合、セルフクリーニング中に触媒体4自体のエッチングが生じると、通常細線状の触媒体径が減少して電気抵抗が増大するため、設定電流源の出力端子間の電圧が上昇する。

したがって、監視装置14によりセルフクリーニング中の端子間電圧を検出することにより触媒体4のエッチングの発生を検出することができる。

[0024] 次に、実施形態1に係るセルフクリーニング触媒化学蒸着装置1による成膜及びin situ(その場)クリーニング方法について説明する。

図1を参照して、本実施形態に係るセルフクリーニング触媒化学蒸着装置1の成膜処理は、反応容器2内に基板(不図示)を搬入し、基板載置台3上に載置する。

次に、反応容器2内を真空排気しつつ、Arガスや水素ガスでパージ後、これらのパージガス雰囲気中で所定圧力に制御しながら、触媒体4に直流電圧を印加して抵抗加熱し、所定温度、例えば、1700℃程度に加熱しておく。

次いで、ガス供給系からガス供給口2aを通して反応容器2内に原料ガス、例えば、 $\text{SiH}_4$ と $\text{H}_2$ の混合ガスの導入に切り換え、ガス排気系によりガス排気口2bを通して反応容器2内を排気して所定の圧力に調整する。

このとき、導入された原料ガスが1700℃に加熱した触媒体4により接触し分解して、ラジカル種が発生し、基板上に薄膜が堆積する。

このような成膜プロセス処理を繰り返すことにより、分解された反応ガスの一部は反応容器2の内壁や基板載置台3等にも堆積膜として付着する。

このため、触媒化学蒸着装置は所定稼動時間毎に反応容器2内をクリーニングする必要がある。

[0025] 次に、実施形態1にかかるセルフクリーニング触媒化学蒸着装置を使用して、反応容器2の内壁や基板載置台3等に付着した付着膜を除去する触媒化学蒸着装置のクリーニング方法について説明する。

本発明の触媒化学蒸着装置のクリーニング方法は、真空排気可能な反応容器2内で抵抗加熱した触媒体4の触媒作用を利用して薄膜を形成する触媒化学蒸着装置

のクリーニング方法であって、抵抗加熱した触媒体4に所定極性のバイアス電圧を印加する過程と、クリーニングガスを導入する過程と、抵抗加熱した触媒体にクリーニングガスが接触し分解してラジカル種を発生する過程と、反応容器内に付着した付着膜を除去するが触媒体自体をエッチングしない過程とを備えるものである。

[0026] 以下、クリーニング方法を詳細に説明する。

まず、反応容器2を真空排気しつつ、Arガスや水素ガスでパージ後、これらパージガス雰囲気中で例えば、65Paに制御しつつ、抵抗加熱により触媒体4を例えば1700°Cに加熱する。

このとき、Arガスを導入するときは、極性を負極性に、水素ガスを導入するときは、極性を正極性にしてバイアス電圧を印加しておく。

次に、ガス供給系の導入ガスの切換え操作によって、ガス供給口2aを通して反応容器2内にクリーニングガスを導入する。

[0027] 本実施形態では、クリーニングガスとして、ハロゲン元素含有ガスの $\text{NF}_3$ （三フッ化窒素）と還元性ガスの $\text{H}_2$ （水素）との混合ガスをそれぞれ20sccm導入する。

還元性ガスとして水素ガスを流すため、極性は前もって正極性にスイッチしておく。

このとき、反応容器2内に混合ガスを導入すると同時に、ガス排気系によりガス排気口2bを通して反応容器2内を真空排気しつつ65Paに調整維持している。

そして、導入されたクリーニングガスが1700°Cになっている触媒体4に接触し分解して発生するハロゲン含有ラジカル種によって反応容器2の内壁や基板載置台3等に付着した付着膜をエッチングして除去し、ガス排気口2bを通して排出する。

このようにして触媒体の触媒作用を利用し、触媒化学蒸着装置を実用的なクリーニング速度で良好なクリーニングをすることができ、しかも触媒体自体のエッチングを抑制することができる。

[0028] 本実施形態の触媒化学蒸着装置のクリーニング方法のクリーニング条件をまとめると、反応容器2内の圧力が65Pa、触媒体4の発熱温度が1700°C程度、 $\text{NF}_3$ と $\text{H}_2$ のそれぞれの流量が20sccm、触媒体4の直径が0.5mmである。

本実施形態のクリーニング時において、定電圧電源8から導線5bに直流バイアス電圧を印加した場合と、このバイアス電圧を印加しない場合における、加熱用電源6

の端子間発生電圧(加熱用電源6から触媒体4に印加する電位)の変化を図2に示す。

図2において、aは定電圧電源8からバイアス電圧を印加しない場合、bは定電圧電源8から+120Vのバイアス電圧を印加した場合、cは定電圧電源8から-180Vのバイアス電圧を印加した場合を示す。

いずれの場合においても、反応容器2の内壁や基板載置台3等に付着した付着膜は良好に除去された。

図2に示す結果から明らかなように、定電圧電源8からバイアス電圧を印加しない場合(図2のa)には、クリーニングが進行するにつれて、加熱用電源6の端子間発生電圧が上昇(約68Vから約77.5V)している。

これは、クリーニング時にクリーニングガスの分解によって発生したハロゲン元素含有ラジカル種によって触媒体4がエッチング(腐食劣化)されて触媒体4の径が小さくなることにより、その電気抵抗が大きくなることによる。

[0029] 一方、定電圧電源8から+120Vのバイアス電圧を印加した場合(図2のb)には、クリーニングが進行しても加熱用電源6の端子間発生電圧の上昇は小さく(約81Vから約84V)、触媒体4のエッチング(腐食劣化)が抑制されている。

また、定電圧電源8から-180Vのバイアス電圧を印加した場合(図2のc)には、クリーニングが進行するにつれて、加熱用電源6の端子間発生電圧が少し上昇(約78Vから約82.5V)しているのは、触媒体4がエッチング(腐食劣化)されたためである。

また、本実施形態において、クリーニングガスとして $\text{NF}_3$ とArの混合ガスを使用した場合においても同様に、定電圧電源8から導線5bに直流バイアス電圧を印加した場合とこのバイアス電圧を印加しない場合における、加熱用電源6の端子間発生電圧(加熱用電源6から触媒体4に印加する電位)の変化を図3に示す。

[0030] 図3において、aは定電圧電源8からバイアス電圧を印加しない場合、bは定電圧電源8から+120Vのバイアス電圧を印加した場合、cは定電圧電源8から-180Vのバイアス電圧を印加した場合を示す。

いずれの場合においても、反応容器2の内壁や基板載置台3等に付着した付着膜は良好に除去された。

このクリーニング時におけるクリーニング条件は、反応容器2内の圧力が65Pa、触媒体4の加熱温度が1700℃程度、 $\text{NF}_3$ とArのそれぞれの流量が20sccm、触媒体4の直径が0.5mmである。

[0031] 図3に示す結果から明らかなように、定電圧電源8からバイアス電圧を印加しない場合(図3のa)には、クリーニングが進行するにつれて、加熱用電源6の端子間発生電圧が上昇(約100Vから約110V)し、触媒体4がエッチング(腐食劣化)される。

また、定電圧電源8から+120Vのバイアス電圧を印加した場合(図3のb)には、クリーニングが進行するにつれて、加熱用電源6の端子間発生電圧が上昇(約82Vから約100V)し、触媒体4がエッチング(腐食劣化)される。

一方、定電圧電源8から-180Vのバイアス電圧を印加した場合(図3のc)には、クリーニングが進行しても加熱用電源6の端子間発生電圧の上昇はほとんどなく、触媒体4のエッチング(腐食劣化)が抑制される。

[0032] 図2、図3に示したような結果は、定電圧電源8からバイアス電圧を印加することにより、触媒体4表面の吸着種を還元又は酸化する駆動力の程度に対応する触媒体4中のd電子及び吸着種からの供与電子の受容軌道(d-空孔)のエネルギーレベル(触媒体4のフェルミ準位と関連がある)が変化し、触媒体4表面に吸着しているハロゲン系ラジカル種及び $\text{H}_2$ のような還元剤と触媒体4との間の表面反応、つまりエッチングの発生又はエッチングの抑制、の速度を変化させていることを示している。

したがって、図2に示したように、クリーニングガスが $\text{NF}_3$ と $\text{H}_2$ の混合ガスの場合には、定電圧電源8から+120Vのバイアス電圧を印加したときに触媒体4のエッチング(腐食劣化)が抑制され、図3に示したようにクリーニングガスが $\text{NF}_3$ とArの混合ガスの場合には、定電圧電源8から-180Vのバイアス電圧を印加したときに触媒体4のエッチング(腐食劣化)が抑制される。

[0033] このように、触媒体4の加熱用電源6、導線5a、5bを反応容器2と電氣的に絶縁状態にし、定電圧電源8から適切な極性で適切な値のバイアス電圧を、加熱用電源6の端子間電位、即ち、加熱用電源6から触媒体4に印加する電位に印加することにより、クリーニングガスによる触媒体4の腐食劣化を抑制し、かつ、クリーニングガスによって反応容器2の内壁や基板載置台3等に付着した付着膜を良好に除去することが

できる。

[0034] また、クリーニングガスによる触媒体4の腐食劣化が抑制されることによって、成膜時においても安定して良好な膜を基板上に堆積できるようになる。

さらに、クリーニング時に従来例のように触媒体4を2000℃以上に加熱する必要がないので、触媒体4自体の蒸発による劣化や、この蒸発にともなう触媒体4の構成要素によって反応容器2内が汚染されることもなく、また、融点の低い廉価な部材を使用することができるのでコストの低減を図れるようになる。

[0035] 〈実施形態2〉

次に実施形態2について説明する。

本実施形態は、図1に示したセルフクリーニング触媒化学蒸着装置1を用い、低電圧電源8から加熱用電源6の端子間電圧にバイアス電圧を印加しないで、零バイアス電圧としたものである。

本実施形態におけるクリーニング条件は、反応容器内の圧力が10Pa、触媒体の線形が0.7mm、触媒体の加熱温度が1700℃であり、クリーニングガスの $\text{NF}_3$ と $\text{H}_2$ との混合ガスとしてそれぞれ20sccm導入したものである。

図4は実施形態2の触媒体自体のエッチングの発生を示す加熱電源用端子間発生電圧とクリーニング時間との関係を示す図であり、aは実施形態2に係るクリーニングガスが $\text{NF}_3$ と $\text{H}_2$ との混合ガスの場合を示し、bは比較例としてクリーニングガスが $\text{NF}_3$ とArの混合ガスの場合を示す。

[0036] 図4に示すように、実施形態2では加熱用電源の端子間発生電圧の勾配が平坦であることから触媒体自体のエッチングがほとんどなく、良好に反応容器内の付着膜を除去することができる。

比較のために、“ $\text{NF}_3$ とArの混合ガス”を使用した場合における、クリーニング時での加熱用電源6の端子間電圧、即ち、加熱用電源6から触媒体4に印加する電位の変化を合わせて示した(図4中のbを参照)。

この比較例のクリーニング条件は実施形態2と同様であり、 $\text{NF}_3$ とArのそれぞれの流量も20sccmである。

[0037] 図4に示す結果から明らかなように、クリーニングガスとして $\text{NF}_3$ とArの混合ガスを

使用した場合よりも $\text{NF}_3$ と $\text{H}_2$ の混合ガスを使用した場合の方が、クリーニングの進行における加熱用電源6の端子間発生電圧の上昇は大幅に小さく、触媒体4のエッチング(腐食劣化)が抑制されている。

図4に示した結果から、クリーニングガスとして $\text{NF}_3$ とArの混合ガスを使用した場合、加熱した触媒体(タングステン線)4に $\text{NF}_3$ が接触分解して発生したフッ素含有ラジカル種の一部が、触媒体4自体を還元剤としてフッ化タングステン( $\text{WF}_x$ ; 通常は $x \leq 6$ )を生成しようとする反応経路が存在するため、触媒体4のエッチング(腐食劣化)が進行するものと推察される。

- [0038] 一方、クリーニングガスとして $\text{NF}_3$ と $\text{H}_2$ の混合ガスを使用した場合には、加熱した触媒体(タングステン線)4に $\text{H}_2$ が接触分解して発生した水素ラジカルも存在し、この水素ラジカルがフッ素含有ラジカル種に対して触媒体4とは競争的な還元剤として作用するため、代替的にフッ化水素(HF)を生成する反応経路も形成されることで、結果的に触媒体4のエッチング(腐食劣化)が抑制されるものと推察される。

また、実施形態1の場合よりも反応容器2内の圧力を小さくしていることも、触媒体4のエッチング(腐食劣化)の抑制に寄与しているものと推察される。

このように、クリーニングガスとして $\text{NF}_3$ と $\text{H}_2$ の混合ガスを使用することによっても、反応容器内に付着した付着膜を除去することができるとともに、触媒体4のエッチング(腐食劣化)を抑制することができる。

[0039] 〈実施形態3〉

次に実施形態3について説明する。

図5は、実施形態3に係るセルフクリーニング触媒化学蒸着装置を示す概略構成図である。

なお、図1に示したセルフクリーニング触媒化学蒸着装置と同一機能を有する部材には同一符号を付し、重複する説明は省略する。

このセルフクリーニング触媒化学蒸着装置20は、反応容器2の外側にクリーニングガスを分解し、ラジカル種を発生するためのラジカル種発生器として、クリーニングガス分解用容器11が設けられている。

クリーニングガス分解用容器11には、RFプラズマやマイクロ波プラズマ等のプラズ

マ発生装置12が設置されており、導入されるクリーニングガス、例えば $\text{NF}_3$ とArの混合ガスを電磁エネルギーによりプラズマ分解してハロゲン含有ラジカル種を発生させることができる。

導入されるクリーニングガスの分解手段としては、プラズマ以外にも他の方法、例えば紫外線を照射する光エネルギーを用いるものでもよい。

他の構成は、図1に示した実施形態1のセルフクリーニング触媒化学蒸着装置1と同様である。

[0040] 以下、本実施形態におけるin situ(その場)クリーニング方法について説明する。

先ず、不活性ガスでパージしつつ、ガス排気系(不図示)によりガス排気口2bを通して反応容器2内を真空排気して所定の圧力、例えば65Paに調整する。

そして、加熱用電源6から導線5a、5bを介して触媒体4に直流電圧を印加して抵抗加熱し、触媒体4を所定温度、例えば1700℃程度に加熱する。

このとき、不活性ガスとしてArガスを使用するので、負極性にしてバイアス電圧を印加しておく。

[0041] 次に、圧力を65Paに調整維持しながらクリーニングガス分解用容器11内にクリーニングガス、本実施形態では $\text{NF}_3$ とArの混合ガスを導入する。

この導入されるクリーニングガス、即ち、 $\text{NF}_3$ とArの混合ガスをプラズマ発生装置12によりプラズマ分解してハロゲン含有ラジカル種を発生させ、このハロゲン含有ラジカル種を反応容器2内に供給し、反応容器2の内壁や基板載置台3等に付着した付着膜をエッチングし除去して、ガス排気口2bを通して排出する。

この際、実施形態1と同様に、制御装置10の制御によって定電圧電源8から適切な極性で適切な値のバイアス電圧を、加熱用電源6の端子間電位(加熱用電源6から触媒体4に印加する電位)に印加する。

これにより、実施形態1で説明したように触媒体4のハロゲン含有ラジカル種による腐食劣化を抑制することができる。

[0042] また、本実施形態のクリーニング時において、ガス供給口2aを通して反応容器2内に還元性ガスとしての $\text{H}_2$ を導入することにより、実施形態2で説明したように触媒体4のハロゲン含有ラジカル種による腐食劣化をより良好に抑制することができる。



本実施形態では、 $H_2$ をガス供給口2aから反応容器2内に供給したが、クリーニングガス分解用容器11にクリーニングガスとともに $H_2$ を導入して、クリーニングガス分解用容器11を通して反応容器2内に供給するようにしてもよい。

[0043] このように、反応容器2の外部に設けたクリーニングガス分解用容器11内でクリーニングガスを分解し、発生したハロゲン含有ラジカル種を反応容器2内に供給して付着膜を除去することにより、反応容器2内の加熱された触媒体4でクリーニングガスを分解する実施形態1の場合よりも効率よく付着膜を除去することができ、クリーニング時間を短縮することができる。

[0044] 以上説明した各実施形態のクリーニング方法では、クリーニングガスとして $NF_3$ を使用した。これ以外にも、例えば $HF$ 、 $C_2F_6$ 、 $C_3F_8$ 、 $SF_6$ 、 $CF_4$ 、 $CClF_3$ 、 $C_2ClF_5$ 、 $CCl_4$ などのハロゲン元素含有ガスを使用することもできる。

#### 産業上の利用可能性

[0045] 本発明のセルフクリーニング触媒化学蒸着装置及びそのクリーニング方法では、抵抗加熱した触媒体の触媒作用を利用して付着物を除去するクリーニングをするが、触媒体自体のエッチングを抑え、付着物だけを除去することができるので、触媒作用により薄膜を形成する触媒化学蒸着装置のクリーニングに有用である。

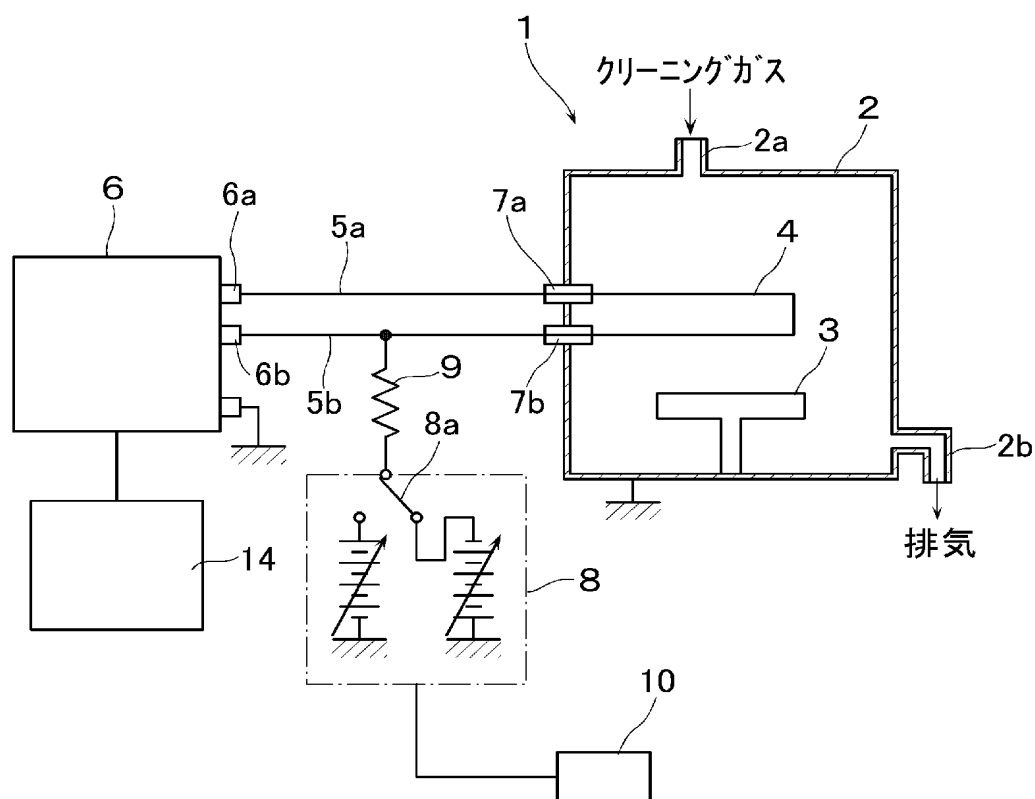
## 請求の範囲

- [1] 真空排気可能な反応容器内で抵抗加熱した触媒体の触媒作用を利用して薄膜を形成する触媒化学蒸着装置において、  
上記触媒体にバイアス電圧を印加するための電源と、印加するバイアス電圧の極性を切り換える切換えスイッチとを備え、  
導入したクリーニングガスが上記抵抗加熱した触媒体に接触し分解して発生したラジカル種と、上記触媒体に印加したバイアス電圧と極性とに基づいて、触媒体自体のエッチングをすることなく、上記反応容器内に付着した付着膜を除去することを特徴とするセルフクリーニング触媒化学蒸着装置。
- [2] 前記構成に加え、クリーニングガスをラジカル種に分解して前記反応容器に導入するラジカル種発生器を設けたことを特徴とする請求項1記載のセルフクリーニング触媒化学蒸着装置。
- [3] 前記クリーニングガスが、ハロゲン元素含有ガスと、不活性ガス及び還元性ガスのいずれかとの混合ガスであることを特徴とする請求項1記載のセルフクリーニング触媒化学蒸着装置。
- [4] 前記クリーニングガスが不活性ガス及び還元性ガスのいずれかを含んでおり、不活性ガス及び還元性ガスの種類に基づいたバイアス電圧の極性にすることを特徴とする請求項1記載のセルフクリーニング触媒化学蒸着装置。
- [5] 前記所定極性のバイアス電圧が零のとき、前記クリーニングガスがハロゲン元素含有ガスと還元性ガスとの混合ガスであることを特徴とする請求項1記載のセルフクリーニング触媒化学蒸着装置。
- [6] 前記ハロゲン元素含有ガスが、 $\text{NF}_3$ 、 $\text{HF}$ 、 $\text{C}_2\text{F}_6$ 、 $\text{C}_3\text{F}_8$ 、 $\text{SF}_6$ 、 $\text{CF}_4$ 、 $\text{CClF}_3$ 、 $\text{C}_2\text{ClF}_5$  及び  $\text{CCl}_4$  のいずれか、或いはこれらの組み合わせであり、前記還元性ガスが  $\text{H}_2$  であり、前記不活性ガスが希ガスであることを特徴とする請求項3、4又は5に記載のセルフクリーニング触媒化学蒸着装置。
- [7] 前記クリーニングガスがハロゲン元素含有ガスと  $\text{H}_2$  との混合ガスであって、正極性の前記バイアス電圧を印加することを特徴とする請求項1記載のセルフクリーニング触媒化学蒸着装置。

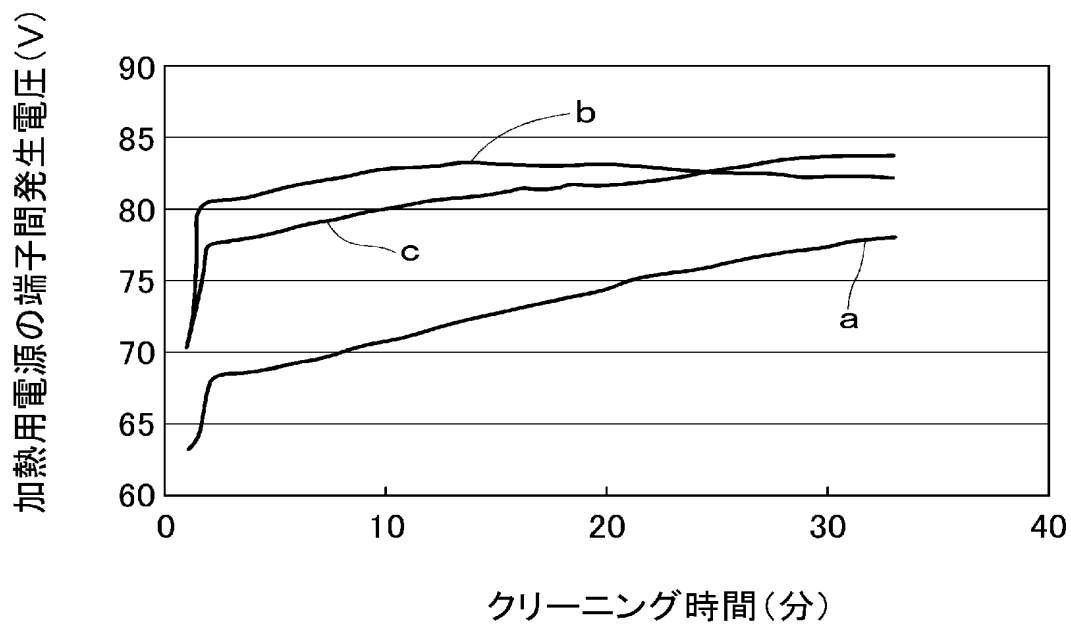
- [8] 前記クリーニングガスがハロゲン元素含有ガスとArとの混合ガスであって、負極性の前記バイアス電圧を印加することを特徴とする請求項1記載のセルフクリーニング触媒化学蒸着装置。
- [9] 前記触媒体自体のエッチングの発生を触媒体の電気抵抗に基づいて検出する監視装置を設けたことを特徴とする請求項1記載のセルフクリーニング触媒化学蒸着装置。
- [10] 真空排気可能な反応容器内で抵抗加熱した触媒体の触媒作用を利用して薄膜を形成する触媒化学蒸着装置のクリーニング方法であって、  
抵抗加熱した触媒体に所定極性のバイアス電圧を印加する過程と、クリーニングガスを導入する過程と、抵抗加熱した触媒体にクリーニングガスが接触し分解してラジカル種を発生する過程と、反応容器内に付着した付着膜を除去するが触媒体自体をエッチングしない過程と、を備えた触媒化学蒸着装置のクリーニング方法。
- [11] 前記クリーニングガスを導入する過程が、クリーニングガスをラジカル種に分解して前記反応容器内に導入する過程であることを特徴とする請求項10記載の触媒化学蒸着装置のクリーニング方法。
- [12] 前記クリーニングガスが、ハロゲン元素含有ガスと、不活性ガス及び還元性ガスのいずれかとの混合ガスであることを特徴とする請求項10記載の触媒化学蒸着装置のクリーニング方法。
- [13] 前記クリーニングガスが不活性ガス及び還元性ガスのいずれかを含んでおり、不活性ガス及び還元性ガスの種類に基づいて決定した極性のバイアス電圧を印加することを特徴とする請求項10記載の触媒化学蒸着装置のクリーニング方法。
- [14] 前記所定極性のバイアス電圧が零のとき、前記クリーニングガスがハロゲン元素含有ガスと還元性ガスとの混合ガスであることを特徴とする請求項10記載の触媒化学蒸着装置のクリーニング方法。
- [15] 前記ハロゲン元素含有ガスが、 $\text{NF}_3$ 、 $\text{HF}$ 、 $\text{C}_2\text{F}_6$ 、 $\text{C}_3\text{F}_8$ 、 $\text{SF}_6$ 、 $\text{CF}_4$ 、 $\text{CClF}_3$ 、 $\text{C}_2\text{ClF}_5$  及び  $\text{CCl}_4$  のいずれか、或いはこれらの組み合わせであり、前記還元性ガスが $\text{H}_2$ であり、前記不活性ガスが希ガスであることを特徴とする請求項12、13又は14に記載の触媒化学蒸着装置のクリーニング方法。

- [16] 前記クリーニングガスがハロゲン含有ガスと $H_2$ との混合ガスであって、正極性の前記バイアス電圧を印加することを特徴とする請求項10記載のセルフクリーニング触媒化学蒸着装置のクリーニング方法。
- [17] 前記クリーニングガスがハロゲン含有ガスとArとの混合ガスであって、負極性の前記バイアス電圧を印加することを特徴とする請求項10記載の触媒化学蒸着装置のクリーニング方法。
- [18] 前記構成に加え、クリーニング中、その場で前記触媒体自体のエッチングの発生を電気抵抗に基づいて監視することを特徴とする請求項10記載の触媒化学蒸着装置のクリーニング方法。

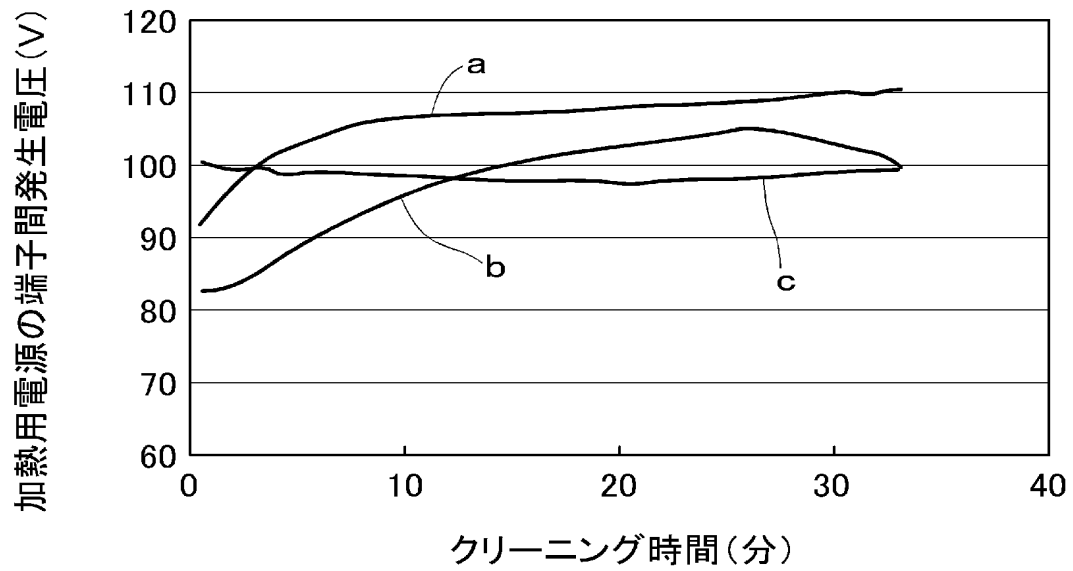
[図1]



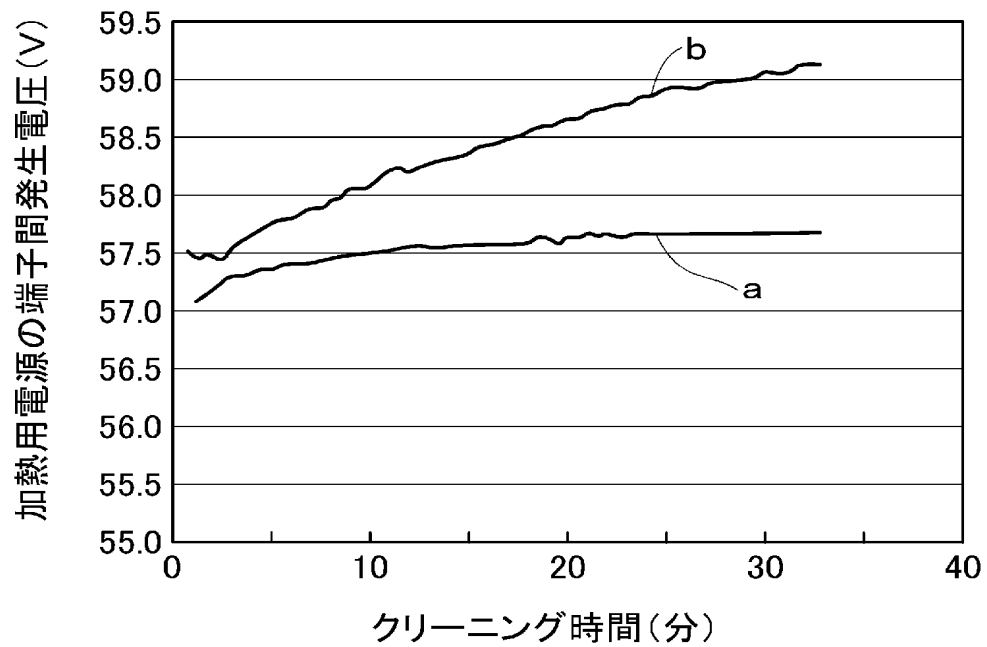
[図2]



[図3]



[図4]





## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/004205

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl.<sup>7</sup> H01L21/205, H01L21/3065, C23C16/44

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl.<sup>7</sup> H01L21/205, H01L21/3065, C23C16/44

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2005	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2002-008997 A (Hitachi Kokusai Electric Inc.), 11 January, 2002 (11.01.02), Full text (Family: none)	1-18
A	JP 2002-093723 A (Anelva Corp.), 29 March, 2002 (29.03.02), Full text (Family: none)	1-18
A	WO 2002/025712 A1 (Japan as represented by President of Japan Advanced Institute of Science and Technology, Hokuriku), 28 March, 2002 (28.03.02), Full text & EP 1258914 A1 & US 6593548 B2	1-18



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

## \* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&amp;" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

08 June, 2005 (08.06.05)

Date of mailing of the international search report

28 June, 2005 (28.06.05)

Name and mailing address of the ISA/

Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/004205

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2004-128322 A (Anelva Corp.), 22 April, 2004 (22.04.04), Full text & US 2004/0065260 A1 & EP 1408535 A2	1-18
A	JP 2002-246310 A (Sony Corp.), 30 August, 2002 (30.08.02), Par. No. [0113]; Fig. 5 & US 2002/0160553 A1	1-18

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.<sup>7</sup> H01L21/205, H01L21/3065, C23C16/44

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.<sup>7</sup> H01L21/205, H01L21/3065, C23C16/44

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2005年
日本国実用新案登録公報	1996-2005年
日本国登録実用新案公報	1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2002-008997 A (株式会社日立国際電気) 2002.01.11, 全文 (ファミリーなし)	1-18
A	JP 2002-093723 A (アネルバ株式会社) 2002.03.29, 全文 (ファミリーなし)	1-18
A	WO 2002/025712 A1 (北陸先端科学技術大学院大学長が代表する日本 国) 2002.03.28, 全文 & EP 1258914 A1 & US 6593548 B2	1-18
A	JP 2004-128322 A (アネルバ株式会社) 2004.04.22, 全文 & US 2004/0065260 A1 & EP 1408535 A2	1-18

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&amp;」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

08.06.2005

国際調査報告の発送日

28.6.2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

池淵 立

電話番号 03-3581-1101 内線 3471

4R

8831

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2002-246310 A (ソニー株式会社) 2002.08.30, 段落【0113】、 図5 & US 2002/0160553 A1	1-18